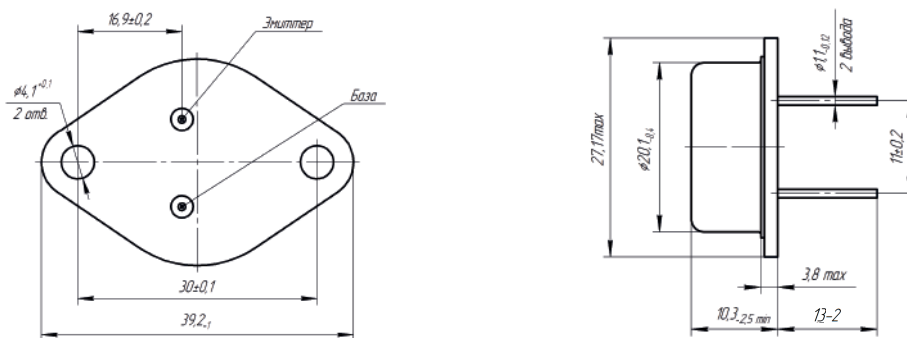


ТРАНЗИСТОРЫ КТ808АМ, КТ808БМ, КТ808ВМ, КТ808ГМ

Кремниевые мезапланарные мощные высоковольтные p-p-n транзисторы в металлостеклянном корпусе предназначены для работы в усилительных и переключающих схемах аппаратуры широкого применения.



Масса транзистора не более 18 г.



КОРПУС КТ-9

Транзисторы соответствуют аА0.336.240 ТУ.

Таблица 1. Основные электрические параметры при T = 25°C

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма			
		КТ808АМ	КТ808БМ	КТ808ВМ	КТ808ГМ
Статический коэффициент передачи тока ($I_K = 2 \text{ A}, U_{KЭ} = 3 \text{ В}$)	$h_{21Э}$	20 – 125	20 – 125	20 – 125	20 – 125
Обратный ток коллектора, мА	$I_{КБО}$	≤ 2			
($U_{КБ} = 250 \text{ В}$)			≤ 2		
($U_{КБ} = 160 \text{ В}$)				≤ 2	
($U_{КБ} = 80 \text{ В}$)					≤ 2
Обратный ток эмиттера ($U_{ЭБ} = 4 \text{ В}$), мА	$I_{ЭБО}$	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15
Граничное напряжение коллектор-эмиттер ($I_K = 100 \text{ мА}, L = 25 \text{ мГн}$), В	$U_{КЭОтр}$	≥ 130	≥ 100	≥ 80	≥ 70
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($I_K = 6 \text{ А}, I_E = 0,6 \text{ А}$), В	$U_{КЭнас}$	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
Напряжение насыщения база-эмиттер ($I_K = 6 \text{ А}, I_E = 0,6 \text{ А}$), В	$U_{БЭнас}$	$\leq 2,5$	$\leq 2,5$	$\leq 2,5$	$\leq 2,5$
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($U_{КЭ} = 10 \text{ В}, I_K = 0,5 \text{ А}, f = 3 \text{ МГц}$)	$ h_{21Э} $	$\geq 2,3$	$\geq 2,3$	$\geq 2,3$	$\geq 2,3$
Время рассасывания ($I_K = 6 \text{ А}, U_K = 30 \text{ В}, I_{Б1} = I_{Б2} = 0,6 \text{ А}$), мкс	$t_{рас}$	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2

Таблица 2. Предельно допустимые режимы эксплуатации

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма			
		КТ808АМ	КТ808БМ	КТ808ВМ	КТ808ГМ
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер, В	$U_{КЭ0max}$	130	100	80	70
Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер, В (при $R_{БЭ} \leq 10 \text{ Ом}$ или при запирающем смещении $U_{ЭБ} \geq 2 \text{ В}$), В	$U_{КЭ, и max}$	250	160	135	80
Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, В	$U_{ЭБ max}$	5	5	5	5
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, А	$I_{К max}$	10	10	10	10
Максимально допустимый импульсный ток коллектора, А	$I_{К, и max}$	12	12	12	12
Максимально допустимый постоянный ток базы, А	$I_{Б max}$	4	4	4	4
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт	$P_{К max}$	70	70	70	70

